

2005年5月16日

半導体用 CMP スラリーの生産能力を3割増強

- 2007年度、売上高100億円を目指す -

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153 億円)は、半導体の素子分離方法の一つである STI(Shallow Trench Isolation)に使用される CMP(化学的機械研磨)スラリーの生産能力を 2005 年 6 月までに約 30%増強します。

CMP(化学的機械研磨：Chemical Mechanical Planarization)とは、半導体の素子分離工程や回路形成工程で発生した凹凸を研磨、平坦化する技術であり、CMP スラリーはこの用途に使用される研磨液です。STI は、シリコンウェハー上の何百万個もの半導体素子をそれぞれ電氣的に絶縁する素子分離方法の一つで、微細配線に適しているため、デザインルール 180 ナノメートル近辺から主流になってきましたが、形成工程上に段差が生じることから CMP による平坦化を行う必要があります。この際、CMP によって発生する研磨傷は歩留りを悪化させるため、130、90 ナノメートルとデザインルールの微細化が進展する上では、信頼性向上のため研磨傷のさらなる低減が必須とされています。

当社は、1998 年度に酸化セリウム粒子を採用した CMP スラリーを実用化し、研磨速度の速さと研磨傷の少なさを武器に、最も平坦化性が求められる STI 向けを中心に売上を拡大してきました。また、2004 年度には研磨傷を従来の 3 分の 1 に低減でき、平坦化性も従来の 2 倍に高めた高性能の STI 用 CMP スラリーを実用化し、売上を拡大してきました。

今般当社は、山崎事業所(勝田)(茨城県ひたちなか市)に約 5 億円を投じ、2005 年 6 月までに製造ラインを 1 ライン増設して、高性能 STI 用 CMP スラリーを含む STI 用 CMP スラリーの量産体制を構築し、生産能力を現在の約 30%増に当たる年間約 2,600 トンに拡大します。

当社では、継続的な増収増益を達成するため、経営資源を集中的に投入して拡大を図る「戦略拡大 10 製品」を定めており、CMP スラリーはその一つです。今回の生産能力増強により、販売強化に努め、2007 年度には約 100 億円の売上高を目指していきます。

以上

(報道関係お問い合わせ先)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 野口 TEL 03-5381-2377